

日程表 (会場別:K101-K406)

3月14日(金)・15日(土)

会場名	収容人数	2025年3月14日(金)		2025年3月15日(土)	
		午前	午後	午前	午後
K101 (講義棟)	214	9:00 ~ 12:15 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 16:40 T23 IoT社会への進展を支える半導体産業のコア技術へ融合と多様化へ	9:00 ~ 12:00 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 17:30 T24 [一般公開]実装技術アラカルトII : 最先端半導体実装技術と将来展望
K102 (講義棟)	214		13:30 ~ 16:50 T29 マテリアルデータベースの新展開 - 知識を蓄積・抽出・俯瞰する -	10:30 ~ 11:45 8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	13:30 ~ 17:40 T14 プラズマ活性溶液とその応用
K103 (講義棟)	265	9:00 ~ 11:15 KS.2 量子情報工学研究会	13:00 ~ 17:15 T1 誤り耐性量子コンピュータへの新技術		13:30 ~ 16:00 NT1 [一般公開]就活生必見! あなたならできる半導体のイノベーション ~ 創造力で新しい時代を~
K201 (講義棟)	126	9:00 ~ 10:45 8.3 プラズマナノテクノロジー	13:00 ~ 17:30 T7 化合物半導体を用いた蛍光体開発の現状と展望		13:30 ~ 17:10 T9 応用物理の交差点: ガラスとレーザープロセスの新展開
K202 (講義棟)	126		14:00 ~ 16:30 チュートリアル (有料)		13:30 ~ 17:55 T12 生物・有機分子ダイナミクスにインスパイアされたセンサ・アクチュエータ機能と開発秩序
K203 (講義棟)	178		13:30 ~ 17:35 T21 多元系発光材料の新展開 - カルコバイライトからペロブスカイトまで -	10:00 ~ 11:25 T11 放射光利用による先端材料研究開発	13:30 ~ 17:20 T11 放射光利用による先端材料研究開発
K204 (講義棟)	126	9:00 ~ 12:00 T18 有機半導体・ペロブスカイトデバイスの最先端計測	13:30 ~ 16:15 T18 有機半導体・ペロブスカイトデバイスの最先端計測	9:30 ~ 11:45 T4 地中、水中、生体内、実装した電界感応技術の全員集合が社会を進展	13:30 ~ 15:30 T4 地中、水中、生体内、実装した電界感応技術の全員集合が社会を進展
K205 (講義棟)	126	10:15 ~ 12:00 1.1 応用物理一般・学際領域	13:30 ~ 17:15 T19 ナノテクノロジーを駆使したバイオセンサーと2次元材料の最前線 - ヒト感染性ウイルスを迅速に検出可能な グラフェンFETセンサーによるパンデミックのない社会の実現 -	9:15 ~ 11:45 1.3 新技術・複合新領域	13:00 ~ 15:30 T5 非大都市圏に向けた科学・エネルギー教育の展開
K206 (講義棟)	126		13:30 ~ 17:25 T17 高温超伝導体の新しい潮流 ~ 銅酸化物を超える材料は現れるのか? ~		13:30 ~ 18:45 T2 グリーンファブの未来を拓く: 持続可能なものづくりへの挑戦
K207 (講義棟)	126		13:30 ~ 19:00 17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	9:00 ~ 12:00 17.2 グラフェン	13:30 ~ 17:45 T3 固体量子ビットを用いた量子科学技術の最前線
K209 (講義棟)	84	9:00 ~ 12:00 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	13:30 ~ 15:15 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	10:15 ~ 11:30 11.1 基礎物性	13:30 ~ 16:45 11.1 基礎物性
K210 (講義棟)	84	9:00 ~ 11:30 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:30 ~ 16:00 13.2 探索的材料物性・基礎物性		13:30 ~ 16:45 1.6 超音波
K301 (講義棟)	160		13:30 ~ 18:15 17.3 層状物質	9:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	15:45 ~ 19:00 17.3 層状物質
K302 (講義棟)	126	10:30 ~ 11:45 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	13:30 ~ 17:15 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	9:00 ~ 12:00 13.9 化合物太陽電池	13:30 ~ 16:30 13.9 化合物太陽電池
K303 (講義棟)	126	9:00 ~ 11:30 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	13:30 ~ 17:00 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	9:00 ~ 11:45 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	13:30 ~ 15:15 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)
K304 (講義棟)	160	9:00 ~ 12:15 3.7 光計測技術・機器	13:30 ~ 18:30 3.7 光計測技術・機器	9:00 ~ 12:15 3.7 光計測技術・機器	15:45 ~ 19:00 3.7 光計測技術・機器
K305 (講義棟)	160		13:30 ~ 17:30 3.1 光学基礎・光学新領域	9:00 ~ 12:15 3.1 光学基礎・光学新領域	13:30 ~ 17:15 3.1 光学基礎・光学新領域
K306 (講義棟)	160	9:00 ~ 11:45 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	13:30 ~ 14:15 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	9:00 ~ 12:00 3.3 生体・医用光学	13:30 ~ 16:30 3.3 生体・医用光学
K307 (講義棟)	84			9:00 ~ 12:30 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	13:30 ~ 17:30 9.4 熱電変換
K308 (講義棟)	84		13:30 ~ 16:30 3.5 超高速・高強度レーザー	10:00 ~ 11:45 3.5 超高速・高強度レーザー	13:30 ~ 15:50 3.5 超高速・高強度レーザー
K309 (講義棟)	84	9:00 ~ 11:45 3.4 レーザー装置・材料	13:30 ~ 17:45 3.4 レーザー装置・材料	9:30 ~ 11:30 3.9 光子物理・技術	13:30 ~ 16:45 3.9 光子物理・技術
K310 (講義棟)	84		12:30 ~ 15:30 1.2 教育	10:00 ~ 12:00 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	14:00 ~ 16:15 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶
K401 (講義棟)	214	9:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 17:30 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 17:30 15.4 III-V族窒化物結晶
K402 (講義棟)	126		13:00 ~ 15:45 15.6 IV族系化合物 (SiC)	9:00 ~ 11:15 12.8 特定テーマ: 有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御	13:00 ~ 15:30 12.8 特定テーマ: 有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御
K403 (講義棟)	126		13:00 ~ 16:45 6.2 カーボン系薄膜	9:00 ~ 12:45 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	14:30 ~ 18:45 12.7 医用工学・バイオチップ
K404 (講義棟)	126		13:30 ~ 18:00 12.2 評価・基礎物性	9:00 ~ 12:15 12.2 評価・基礎物性	13:45 ~ 18:45 12.2 評価・基礎物性
K405 (講義棟)	214	11:00 ~ 12:00 授賞式	16:00 ~ 18:00 授賞式	9:00 ~ 12:00 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	13:00 ~ 17:15 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池
K406 (講義棟)	126		13:00 ~ 17:15 12.1 作製・構造制御	9:00 ~ 12:00 KS.2 量子情報工学研究会	13:30 ~ 16:00 KS.2 量子情報工学研究会

日程表 (会場別:K101-K406)

3月16日(日)・17日(月)

会場名	収容人数	2025年3月16日(日)		2025年3月17日(月)	
		午前	午後	午前	午後
K101 (講義棟)	214	9:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	13:30 ~ 16:55 T26 極薄物質で本当に良いセンサーができるのか? ~ ナノチューブ・二次元材料を用いた分子センシングの現状と課題 ~	9:00 ~ 12:30 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 16:45 13.5 デバイス/配線/集積化技術
K102 (講義棟)	214	9:00 ~ 11:15 10.5 磁場応用	13:30 ~ 17:45 T16 磁気・スピンをみる一イメージング技術を駆使したマグネティクス・スピントロニクスの新展開 ~	9:30 ~ 11:45 17.3 層状物質	13:30 ~ 16:45 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス
K103 (講義棟)	265	9:00 ~ 11:45 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:30 ~ 18:05 T10 革新的フォトニクスが拓く光学の最前線	9:00 ~ 12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:30 ~ 16:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術
K201 (講義棟)	126		13:30 ~ 17:30 NT2 【一般公開】理工系人材の枯渇危機をどう乗り越えるか?! - 15歳からのキャリアパスを考える -	9:00 ~ 11:45 2.2 発生装置・検出器開発・計測技術	13:30 ~ 16:25 T8 植物RIイメージング技術の開発と農業への応用
K202 (講義棟)	126	9:30 ~ 12:00 T15 原子層プロセス (ALP: Atomic Layer Process) の解析技術と応用技術	13:30 ~ 17:15 T15 原子層プロセス (ALP: Atomic Layer Process) の解析技術と応用技術	9:30 ~ 11:45 13.3 絶縁膜技術	13:00 ~ 14:45 13.3 絶縁膜技術
K203 (講義棟)	178	9:00 ~ 11:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:30 ~ 17:40 T13 次世代トランジスタに向けた新規機能性酸化物半導体チャネル材料・デバイス・作製技術の新展開		
K204 (講義棟)	126	10:00 ~ 12:05 T6 【一般公開】音と応用物理のコラボレーション	13:30 ~ 15:45 T6 【一般公開】音と応用物理のコラボレーション	10:15 ~ 12:00 T20 有機エレクトロニクス技術の現状と将来展望	13:30 ~ 15:45 T20 有機エレクトロニクス技術の現状と将来展望
K205 (講義棟)	126	9:00 ~ 10:30 16.2 エナジーハーベスティング	13:00 ~ 17:30 T27 カーボンニュートラルを実現する半導体低消費電力化技術の最前線	10:00 ~ 11:35 T28 ナノスケール熱輸送現象と制御の最前線	13:00 ~ 15:05 T28 ナノスケール熱輸送現象と制御の最前線
K206 (講義棟)	126	9:00 ~ 10:45 11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用	13:00 ~ 15:15 11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長		
K207 (講義棟)	126	9:00 ~ 11:45 17.2 グラフェン			
K209 (講義棟)	84	9:00 ~ 12:00 11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	13:30 ~ 18:00 11.4 アナログ応用および関連技術	10:00 ~ 12:00 1.5 計測技術・計測標準	13:30 ~ 15:45 1.5 計測技術・計測標準
K210 (講義棟)	84				
K301 (講義棟)	160	9:00 ~ 12:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	14:00 ~ 17:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	9:00 ~ 11:45 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:15 ~ 17:00 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価
K302 (講義棟)	126	10:00 ~ 11:30 13.8 光物性・発光デバイス	13:30 ~ 15:00 13.8 光物性・発光デバイス	10:00 ~ 11:30 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	13:30 ~ 16:00 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス
K303 (講義棟)	126	9:00 ~ 11:45 8.4 プラズマライファイエンス	13:30 ~ 16:00 8.4 プラズマライファイエンス	9:00 ~ 12:00 8.1 プラズマ生成・診断	13:30 ~ 16:00 8.1 プラズマ生成・診断
K304 (講義棟)	160		13:30 ~ 17:15 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野 17:15 ~ 17:45 8.6 Plasma Electronics English Session	9:00 ~ 12:00 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	13:30 ~ 15:45 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理
K305 (講義棟)	160	9:00 ~ 11:15 3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御	13:30 ~ 18:00 3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御	9:00 ~ 11:30 3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御	13:30 ~ 17:00 3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御
K306 (講義棟)	160	9:00 ~ 12:00 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	13:30 ~ 16:30 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	9:00 ~ 12:00 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	13:30 ~ 16:45 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」
K307 (講義棟)	84	9:00 ~ 11:45 9.3 ナノエレクトロニクス	13:30 ~ 18:30 9.1 誘電材料, 誘電体		13:00 ~ 17:00 9.5 新機能材料・新物性
K308 (講義棟)	84	9:00 ~ 11:30 16.3 シリコン系太陽電池	13:30 ~ 17:15 16.3 シリコン系太陽電池	9:30 ~ 11:30 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:30 ~ 16:45 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス
K309 (講義棟)	84	10:00 ~ 11:15 9.4 熱電変換	13:30 ~ 16:15 3.12 半導体光デバイス	10:00 ~ 12:30 3.12 半導体光デバイス	
K310 (講義棟)	84	9:30 ~ 11:30 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:30 ~ 14:45 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	9:30 ~ 12:00 15.1 バルク結晶成長	13:30 ~ 14:00 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶
K401 (講義棟)	214	9:00 ~ 11:30 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00 ~ 17:30 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	
K402 (講義棟)	126	9:00 ~ 11:30 CS.7 12.6 ナノバイオテクノロジー, 12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア	13:00 ~ 17:15 12.6 ナノバイオテクノロジー	9:00 ~ 11:30 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:00 ~ 16:00 12.6 ナノバイオテクノロジー
K403 (講義棟)	126	9:30 ~ 11:15 6.2 カーボン系薄膜	13:00 ~ 16:45 12.7 医用工学・バイオチップ	9:00 ~ 11:30 12.7 医用工学・バイオチップ	13:00 ~ 16:45 12.7 医用工学・バイオチップ
K404 (講義棟)	126		13:00 ~ 16:00 12.4 有機EL・トランジスタ		13:00 ~ 16:30 12.4 有機EL・トランジスタ
K405 (講義棟)	214	9:00 ~ 11:30 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	13:00 ~ 17:00 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	9:00 ~ 11:45 CS.6 タンデム太陽電池 (12.5 有機・ハイブリッド太陽電池, 13.9 化合物太陽電池, 16.3 シリコン系太陽電池のコードシェア)	13:00 ~ 15:15 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池
K406 (講義棟)	126	9:00 ~ 11:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:00 ~ 17:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	9:00 ~ 11:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:00 ~ 15:15 12.3 機能材料・萌芽的デバイス

日程表 (会場別:K501-K509,Y1311, P)

3月14日(金)・15日(土)

会場名	収容人数	2025年3月14日(金)		2025年3月15日(土)	
		午前	午後	午前	午後
K501 (講義棟)	126			10:00 ~ 11:15 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:00 ~ 16:30 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」
K502 (講義棟)	126	9:30 ~ 11:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:00 ~ 16:15 2.4 ライフサイエンス・医療・宇宙地球環境・放射線教育	9:00 ~ 11:45 2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価	13:00 ~ 17:00 2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価
K503 (講義棟)	178		13:00 ~ 17:45 CS.3 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア	9:00 ~ 11:15 6.1 強誘電体薄膜	13:00 ~ 17:00 6.1 強誘電体薄膜
K504 (講義棟)	178		13:00 ~ 16:30 3.8 テラヘルツ全般	9:15 ~ 11:30 3.8 テラヘルツ全般	13:00 ~ 17:30 3.8 テラヘルツ全般
K505 (講義棟)	178		13:30 ~ 17:30 3.10 フォトニック構造・現象	9:30 ~ 11:45 3.10 フォトニック構造・現象	13:15 ~ 15:30 3.10 フォトニック構造・現象 15:45 ~ 18:30 CS.2 3.10 フォトニック構造・現象、3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御のコードシェア
K506 (講義棟)	178	9:00 ~ 11:45 3.11 ナノ領域光学・近接場光学	13:15 ~ 18:00 3.11 ナノ領域光学・近接場光学	9:00 ~ 11:45 3.11 ナノ領域光学・近接場光学	13:15 ~ 18:30 3.11 ナノ領域光学・近接場光学
K507 (講義棟)	84	9:00 ~ 11:30 CS.5 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェア	13:00 ~ 18:00 CS.5 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェア	9:00 ~ 11:15 7.2 電子ビーム応用	13:00 ~ 15:15 7.2 電子ビーム応用
K508 (講義棟)	84		13:00 ~ 16:15 3.14 Optics and Photonics English Session	9:00 ~ 11:15 3.2 情報フォトニクス・画像工学	13:00 ~ 18:15 3.2 情報フォトニクス・画像工学
K509 (講義棟)	84			10:00 ~ 11:30 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	13:30 ~ 15:15 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション
Y1311 (13号館)	500		14:00 ~ 15:30 T22 次世代半導体創生に向けた研究・人財育成活動シンポジウム		13:30 ~ 16:45 T25 極限環境デバイス
P 森戸記念 体育館		[09:30-11:30] 2 放射線 7 ビーム応用 8.4 プラズマライフサイエンス 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野 11 超伝導	[13:30-15:30] 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.4 薄膜新材料 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎 15.4 III-V族窒化物結晶 FS フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	[09:30-11:30] 3.6 レーザープロセッシング 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 12.4 有機EL・トランジスタ 12.6 ナノバイオテクノロジー 12.7 医用工学・バイオチップ 16 非晶質・微結晶	[13:30-15:30] 3.4 レーザー装置・材料 3.7 光計測技術・機器 3.13 シリコンフォトニクス・光電融合集積・光制御 3.14 Optics and Photonics English Session 17 ナノカーボン・二次元材料 23 合同セッションN「インフォマティクス応用」
			[16:00-18:00] 1 応用物理学一般 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥 T22 次世代半導体創生に向けた研究・人財育成活動シンポジウム		[16:00-18:00] 10 スピントロニクス・マグネティクス 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術 13.5 デバイス/配線/集積化技術 13.8 光物性・発光デバイス 21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」

日程表 (会場別:K501-K509,Y1311, P)

3月16日(日)・17日(月)

会場名	収容人数	2025年3月16日(日)		2025年3月17日(月)	
		午前	午後	午前	午後
K501 (講義棟)	126		13:00 ~ 18:15 2.2 発生装置・検出器開発・計測技術	9:30 ~ 11:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:00 ~ 15:30 6.3 酸化物エレクトロニクス
K502 (講義棟)	126	9:00 ~ 11:30 2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価	13:00 ~ 16:45 2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価	9:00 ~ 11:30 CS.4 6.2 カーボン系薄膜、KS.1 固体量子センサ研究会のコードシェア	13:00 ~ 15:15 CS.4 6.2 カーボン系薄膜、KS.1 固体量子センサ研究会のコードシェア
K503 (講義棟)	178		13:00 ~ 15:30 KS.1 固体量子センサ研究会	10:00 ~ 11:30 6.6 プロープ顕微鏡	13:00 ~ 16:30 6.6 プロープ顕微鏡
K504 (講義棟)	178	10:00 ~ 11:30 6.6 プロープ顕微鏡	13:00 ~ 17:00 6.4 薄膜新材料	9:30 ~ 11:00 6.4 薄膜新材料	
K505 (講義棟)	178	9:00 ~ 11:30 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	13:00 ~ 17:45 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	9:00 ~ 11:30 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	13:00 ~ 16:30 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」
K506 (講義棟)	178	9:00 ~ 11:45 3.6 レーザープロセス	13:00 ~ 18:30 3.6 レーザープロセス	9:00 ~ 12:00 3.6 レーザープロセス	
K507 (講義棟)	84		13:00 ~ 17:30 CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、 7.4 イオンビーム一般のコードシェア	9:00 ~ 10:45 7.1 X線技術	13:00 ~ 14:45 7.3 微細パターン・微細構造形成技術
K508 (講義棟)	84	9:00 ~ 12:00 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:00 ~ 14:45 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学		
K509 (講義棟)	84				
Y1311 (13号館)	500	9:00 ~ 11:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:00 ~ 17:15 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	9:00 ~ 11:45 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:00 ~ 15:45 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」
P 森戸記念 体育館		[09:30-11:30] 3.1 光学基礎・光学新領域 3.2 情報フォトニクス・画像工学 3.3 生体・医用光学 3.5 超高速・高強度レーザー 3.8 テラヘルツ全般 3.10 フォトニクス構造・現象 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 3.12 半導体光デバイス 22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	[13:30-15:30] 8.1 プラズマ生成・診断 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理 8.3 プラズマナノテクノロジー 12.1 作製・構造制御 12.2 評価・基礎物性 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	[09:30-11:30] 9 応用物性 12.8 特定テーマ：有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御	
			[16:00-18:00] 6.1 強誘電体薄膜 6.2 カーボン系薄膜 6.5 表面物理・真空 6.6 プロープ顕微鏡 13.2 探索的材料物性・基礎物性 13.3 絶縁膜技術 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス 13.9 化合物太陽電池 KS 研究会セッション		